

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОППОНЕНТАХ

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Место основной работы (почтовый индекс, адрес, телефон по месту работы), должность	Ученая степень (с указанием шифра специальности, по которой защищена диссертация). Ученое звание (по специальности, кафедре)
Жихарев Валентин Александрович	1947	420015, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, 68, Телефон по месту работы: +7(843)231-41-08. e-mail: zhikharev@kstu.ru Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ») Кафедра высшей математики, заведующий кафедрой	Доктор физико-математических наук специальность: 01.04.11 – «Физика магнитных явлений» профессор
Скворцов Аркадий Алексеевич	1968	107023, Россия, г. Москва, ул. Б.Семёновская, д. 38. Телефон по месту работы +7 (495) 223-05-23, доб. 1457 e-mail: sopr@mami.ru Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)» (ФГБОУ ВО «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)») Кафедра «Сопротивление материалов», заведующий кафедрой	Доктор физико-математических наук специальность: 01.04.10 – «Физика полупроводников» профессор

Список публикаций официального оппонента д.ф.-м.н. Жихарева В. А.

1. Жихарев В.А. Тагиров М.С. / Актуальные проблемы магнитного резонанса и его приложений: Анатолий Абрагам, Евгений Завойский, Казань. // Физика низких температур. 2015. Т. 41. №1. С. 3 – 6.
2. Balakirev N. A., Zhikharev V. A. / Magnetic resonance in ion-beam synthesized Fe_3Si films (computer simulation) // Phys. Status Sol. (c). – 2015. – Vol. 12. – No. 1 – 2. P. 39 – 43.
3. Balakirev N., Zhikharev V., Gumarov G. / The formation of magnetic silicides Fe_3Si clusters during ion implantation // Nuclear Instr. and. Meth. In Phys. Res. B. 2014. V. 326. P. 61 – 64.
4. Балакирев Н.А., Жихарев В.А. / Резонансное СВЧ поглощение в двумерном массиве сферических магнитных частиц // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – Т.17. – Вып. 8. – С. 11 – 14.
5. Балакирев Н.А., Жихарев В.А. / Модель роста кластеров сложных силицидов при ионной имплантации // Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – Т.16. – Вып. 2. – С. 21 – 24.
6. Gumarov G., Petuhkov, V., Zhikharev V. Konovalov D. Nushdin V. Alexeev A. / Scanning MOKE investigation of ion-beam synthesised silicide films // Nuclear Instr. and. Meth. In Phys. Res. B. – 2012. – V. 282. – P. 92 – 95.
7. Balakirev N.A., Gumarov G.G., Zhikharev V.A. / Investigation of magnetic properties of thin films using computer simulation // Journal of Phys. Conference Series. – 2012. – Vol. 356. – P. 012042-1 – 012042-7.
8. Балакирев Н.А., Жихарев В.А. / Ферромагнитный резонанс в двумерном кластере // Вестник Казанского технологического университета. – 2011. Т.14. Вып. 20. С. 16 – 20.
9. Balakirev N.A., Zhikharev V.A., Gumarov G.G., Petuhkov, V. Yu. / Model of anisotropic growth of magnetic clusters at ion beam synthesis // Comp. Material Science. 2011. V. 50. P. 2925 – 2929.

Список публикаций официального оппонента д.ф.-м.н. Скворцова А. А.

1. A. A. Skvortsov, S. M. Zuev, M. V. Koryachko. / Non-stationary phase transitions in systems metallization of silicon structures // Russian Microelectronics. – 2016. – Vol. 45(3). – P. 215 – 222.
2. Скворцов А.А., Каризин А.В., Волкова Л.В., Корячко М.В. / Влияние постоянного магнитного поля на дислокационный ангармонизм в кремнии // Физика твердого тела. – 2015. – Т. 57. – Вып. 5. – Стр. 898 – 902.
3. Скворцов А.А., Каризин А.В. / Магнитопластичность и диффузия в монокристаллах кремния // ЖЭТФ. – 2012. – Т. 141. – Вып. 1. – Стр. 96 – 100.
4. Скворцов А.А., Каленков С.Г., Корячко М.В. / Фазовые превращения в системах металлизации при нестационарном тепловом воздействии // Письма в журнал технической физики. – 2014. – Т.40. – В. 18. – Стр. 24 – 32.
5. A. A. Skvortsov, A. M. Orlov, S. M. Zuev. / Diagnostics of degradation processes in the metal-semiconductor system // Russian Microelectronics. – 2012. – Vol. 41(1). – P. 31 – 40.
6. Скворцов А.А., Мурадов В.Е., Каштанова Е.А. / К вопросу об электромиграции расплавленных включений в системе алюминий-кремний // Письма в журнал технической физики. – 2011. – Т.37. – Вып. 11. Стр. 35 – 42.
7. Скворцов А.А., Орлов А.М., Фролов В.А., Гончар Л.И., Литвиненко О.В. / Влияние магнитного поля на акустическую эмиссию в дислокационном кремнии при токовых воздействиях // Физика твердого тела. – 2000. – Т.42. – Вып. 10. – С. 1814 – 1817.
8. Скворцов А.А., Орлов А.М., Соловьев А.А., Белов Д.И. / Магнитопластический эффект в кремнии: поиск новых методов управления структурно-чувствительными свойствами элементарных полупроводников // Физика твердого тела. – 2009. – Т. 51. – Вып. 12. – Стр. 2304 – 2308.
9. Орлов А.М., Скворцов А.А., Гончар Л.И. / Магнитостимулированное изменение подвижности дислокаций в пластически деформированном кремнии n-типа // Физика твердого тела. – 2001. – Т.43. – Вып. 7. – С. 1207 – 1210.
10. Скворцов А.Л., Орлов Л.М., Гончар Л.И. / Влияние слабого магнитного поля на подвижность дислокаций в кремнии // ЖЭТФ. – 2001. – Т. 120. – Вып. 1(7). – С. 134 – 138.
11. Орлов А.М., Скворцов А.А., Соловьев А.А. / Поведение дислокаций в кремнии при наличии механических и магнитных возмущений // ЖЭТФ. – 2003. – Т. 123. – Вып. 3. – С. 590 – 598.
12. Скворцов А.А., Гончар Л.И., Орлов А.М. / Электростимулированный транспорт дислокаций в постоянном магнитном поле // ФТТ. – 2003. – Т.45. – Вып. 9. – С.1603 – 1607.